

12/8(火)	講演タイトル	講演者名	所属
10:00~10:55	半導体の絶縁破壊現象の基礎 Fundamentals of Breakdown Phenomena in Semiconductors	須田 淳	名古屋大学
11:00~11:55	信頼度解析の基礎 Basics of Reliability Theory	大村 一郎	九州工業大学
13:00~13:55	Si-IGBTならびにSiC-MOSFET負荷短絡時の破壊メカニズム Investigation of Short-circuit Failure Mechanisms of Si IGBTs and SiC MOSFETs	岩室 憲幸	筑波大学
14:00~14:55	ワイドバンドギャップ半導体MOSデバイスにおけるゲート酸化膜破壊 Gate oxide breakdown in wide bandgap semiconductor MOS devices	細井 卓治	大阪大学
15:00~15:55	高信頼高密度ハーフブリッジSiCパワーモジュール Highly reliable and dense half-bridge SiC power module	谷本 智	大阪大学 福島SiC応用技術株式会社 (FSiC)
16:00~16:55	半導体デバイスの放射線劣化・破壊 –地上から宇宙まで– Radiation degradation & destruction of semiconductor devices – From terrestrial to space applications -	大島 武	量子科学技術研究開発機構